

8月5日（星期三）

午餐

分会报告	材料生长及物性表征 (一)	光电子材料与器件 (一)	功率电子与射频电子器件 (一)	新兴半导体材料及应用 (一)
主持人	汪莱	魏同波	陆海	单崇新
12:10-14:00	午餐			
14:00-14:20	IA1(邀请报告): 蓝宝石衬底上GaN基共振隧穿二极管研究 王丁, 陈兆营, 王涛, 杨流云, 张宝庆, 苏娟, 谭为, 郭世平, 王新强 北京大学 清华大学 中微半导体设备有限公司	IB1(邀请报告): 氮极性Ga_N薄膜的外延生长研究 张源涛, 邓高强, 余焯, 刘放, 王新强 吉林大学 北京大学	IC1(邀请报告): 用于微波无线传能和大功率检波的近理想Ga_N二极管研究 张进成, 张涛, 党魁, 张燕妮, 周弘, 郝跃 西安电子科技大学	ID1(邀请报告): 超宽禁带氧化镓半导体器件发展态势和机遇 龙世兵 中国科学技术大学
14:20-14:40	IA2(邀请报告): 高质量超薄AlGa_N/Ga_N HEMT外延技术研究 李忠辉, 张东国, 彭大青, 杨乾坤, 李传皓, 罗伟科, 董逊 南京电子器件研究所	IB2(邀请报告): 氮化物/蓝宝石界面构型及原子级堆叠过程及氮化物范德华外延 刘志强, 梁萌, 伊晓燕, 王军喜, 李晋闽 中国科学院半导体研究所	IC2(邀请报告): MOCVD选区掺杂氮化物及毫米波器件 张韵, 张连, 程哲, 何亚伟, 高幸发 中国科学院半导体研究所, 中国科学院大学材料科学与光电技术学院	ID2(邀请报告): β-Ga₂O₃单晶衬底材料新进展 郝建民 中国电子科技集团公司第四十六研究所
14:40-14:55	OA1(口头报告): 基于超薄Ga_N量子阱结构的光泵浦深紫外激光器的MOCVD外延生长 张毅, 单茂诚, 郑志华, 李晓航, 戴江南*, 陈长清 华中科技大学	OB1(口头报告): 短波红外砷磷化合物光电材料研究 顾溢, 王红真, 朱莎露, 陈平平, 马英杰, 张永刚, 李雪, 龚海梅 中国科学院上海技术物理研究所 中国科学院上海微系统与信息技术研究所	OC1(口头报告): 具有强雪崩泄放能力的650V/8A准垂直Ga_N肖特基二极管研究 周峰, 徐尉宗, 任芳芳, 陈敦军, 张荣, 郑有焯, 陆海 南京大学	OD1(口头报告): Ga₂O₃薄膜的高温MOCVD外延、掺杂与探测器制备 董鑫, 李曠明, 焦腾, 张源涛, 张宝林 吉林大学
14:55-15:10	OA2(口头报告): 利用掺杂突变提高Ga_N基垂直腔面发射激光器的电流扩展效应 张勇辉, 邱雪皎, 张紫辉, 田康凯, 车佳滢, 邵华, 常乐, 刘亚津, 张际, 张丹扬, 贾兴宇 河北工业大学	OB2(口头报告): 面向Micro-LED应用的InGa_N基高效橙红光LED研究 张胜男, 张建立, 王小兰, 郑畅达, 高江东, 吴小明, 徐龙权, 丁杰, 江风益 南昌大学	OC2(口头报告): 基于Ar离子注入终端的准垂直硅基Ga_N SBD及漏电机理研究 郭小路, 钟耀宗, 周宇, 苏帅, 陈昕, 刘建勋, 高宏伟, 孙钱, 杨辉 中国科学技术大学纳米技术与纳米仿生学院, 中科院苏州纳米技术与纳米仿生研究所	OD2(口头报告): 基于雾化化学气相沉积法异质外延生长单晶β-Ga₂O₃薄膜 许育, 张春福, 成邀林, 李哲, 冯倩, 张进成, 郝跃 西安电子科技大学
15:10-15:25	OA3(口头报告): 200 mm硅晶圆上外延生长的In_xGa_{1-x}As/GaAs超晶格位错过滤层的有效性研究 王冰 中山大学	OB3(口头报告): 无荧光粉多基色白光LED空间颜色均匀性研究 朱昕, 郭醒, 罗昕, 徐龙权, 张建立, 江风益 南昌大学	OC3(口头报告): 一种基于快速肖特基刻蚀及场板电场调控的3.4 kV AlGa_N/Ga_N 硅基肖特基二极管 徐儒, 陈鹏, 刘梦涵, 李一萌, 周婧, 刘斌, 谢自力, 张荣, 郑有焯 南京大学	OD3(口头报告): β-氧化镓薄膜的微结构研究 李悦文, 修向前, 张丽颖, 华雪梅, 谢自力, 陈鹏, 刘斌, 张荣, 郑有焯 南京大学
15:25-15:40	OA4(口头报告): GaN离子注入p型掺杂技术 石娅婷, 徐尉宗, 陈选虎, 任芳芳, 周东, 叶建东, 陈敦军, 张荣, 郑有焯, 陆海 南京大学	OB4(口头报告): 基于三维结构的高显指白光LED器件 赵捷, 魏同波, 王军喜, 李晋闽 中国科学院半导体研究所 中国科学院大学	OC4(口头报告): 用于获得高击穿电压和低漏电流的Mesa型Ga_N基肖特基势垒二极管的设计策略 田康凯, 贾兴宇, 张紫辉, 刘亚津, 车佳滢, 邵华, 常乐, 邱雪皎, 张际, 张丹扬, 张勇辉 河北工业大学	OD4(口头报告): 利用MOCVD制备高质量的Si掺杂氧化镓同质外延薄膜 季学强, 岳建英, 陈旭, 陈政委, 唐为华 北京镓族科技有限公司 北京邮电大学

分会邀请报告20分钟，口头报告15分钟(均含问答时间)

8月5日（星期三）

15:40-16:00

茶歇

分会报告	材料生长及物性表征 (二)	光电子材料与器件 (二)	功率电子与射频电子器件 (二)	新兴半导体材料及应用 (二)
主持人	李忠辉	戴江南	张进成	龙世兵
16:00-16:20	IA3(邀请报告): GaN单晶材料的掺杂与电学特性调控 王建峰, 张育民, 蔡德敏, 徐俞, 王明月, 胡晓剑, 徐科 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 苏州纳维科技有限公司	IB3(邀请报告): 半导体仿真技术在第三代半导体器件中的应用 张紫辉, 张勇辉, 田康凯, 楚春双, 车佳滢, 邵华, 寇建权, 贾兴宇, 张际, 高元斌, 杭升, 邱雪娇, 常乐, 刘亚津, 张丹扬 河北工业大学	IC3(邀请报告): 硅基GaN电子器件及材料研究进展 孙钱 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所	ID3(邀请报告): 金刚石超宽禁带半导体材料与器件研究 单崇新, 林超男, 杨珣, 杨西贵 郑州大学
16:20-16:40	IA4(邀请报告): 宽禁带半导体自旋和谷电子学性质研究 唐宁, 刘星辰, 张晓玥, 张仕雄, 葛惟昆, 沈波 北京大学	IB4(邀请报告): Analysis of TM/TE mode enhancement and droop reduction by a nanoporous n-AlGaIn underlayer in a 290 nm UV-LED 李虞锋, 王辰雨, 张烨, 胡鹏, 张胜楠, 苏喜林, 杜梦琦, 李强, 云峰 西安交通大学	IC4(邀请报告): 超薄势垒AlGaIn/GaN异质结构功率器件与集成研究 黄森, 王鑫华, 魏珂, 刘新宇 中国科学院微电子研究所, 中国科学院大学	ID4(邀请报告): 超宽禁带氧化镓功率器件技术进展与展望 吕元杰, 王元刚, 刘宏宇, 敦少博, 梁士雄, 冯志红, 蔡树军 中国电子科技集团公司第十三研究所
16:40-17:00	IA5(邀请报告): 真空紫外光电子材料与器件 郑伟 中山大学	OB5(口头报告): 氮极性III族氮化物隧穿结LED制备研究 邓高强, 余焯, 王阳, 张源涛 吉林大学	OC5(口头报告): 基于p型栅二次外延的GaN基增强型HEMT栅极可靠性 钟耀宗, 苏帅, 周宇, 陈昕, 高宏伟, 詹晓宁, 郭小路, 孙钱, 杨辉 苏州纳米技术与纳米仿生研究所	ID5(邀请报告): 氧化镓半导体材料外延与日盲探测器应用 叶建东, 顾书林, 张荣, 郑有焯 南京大学
17:00-17:15	OA5(口头报告): Dynamics of localized excitons in monolayer GaN/AlN quantum wells Maocheng Shan, Yi Zhang, Changqing Chen, Xiaohang Li Huazhong University of Science and Technology King Abdullah University of Science and Technology (KAUST)	OB6(口头报告): 电注入绿光GaN微腔中的三维限制光子态 梅洋, 陈衍晖, 徐欢, 许荣彬, 郑志威, 龙浩, 应磊莹, 张保平 厦门大学	OC6(口头报告): Temperature-Dependent Dynamic R_{ON} of GaN HEMT under Hard-Switching Shaocheng Li, Shu Yang, and Kuang Sheng Zhejiang University	OD5(口头报告): MOCVD外延生长Ga₂O₃/GaN异质结及其日盲紫外探测器应用 林日成, 郑伟, 张丹, 黄丰 中山大学
17:15-17:30	OA6(口头报告): 室温下通过极化电场有效调控InGaIn/GaN量子阱的自旋弛豫时 刘星辰, 唐宁, 张仕雄, 张晓玥, 管鸿明, 张云帆, 钱轩, 姬扬, 葛惟昆, 沈波 北京大学 中国科学院半导体所半导体超晶格国家重点实验室	OB7(口头报告): 大功率GaN基蓝光超辐射发光二极管 熊巍, 胡磊, 刘建平, 杨辉 中科院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 中国科学技术大学	OC7(口头报告): GaN HEMT器件高频可靠性研究及高频开关电源应用 雷建明, 郭慧, 王蕊, 陈敦军, 陆海, 张荣, 郑有焯 南京大学, 南京工业职业技术大学	OD6(口头报告): 高质量亚稳相α-In₂O₃异质外延及其生长机理研究 况悦, 马同川, 陈选虎, 叶建东, 顾书林, 张荣, 郑有焯 南京大学
17:30-17:45	OA7(口头报告): 基于晶面变化的GaN/AlN量子结构能带调控 闫金健, 董悦, 林伟, 康俊勇 厦门大学	OB8(口头报告): 金属有机源(MO源)的技术发展 俞冬雷, 徐昕, 王伟 安徽亚格盛电子新材料有限公司	OC8(口头报告): Threshold voltage shift in AlN/Al_{0.05}Ga_{0.95}N HEMTs on Si substrate by surface states adjustment Xi Liu, Weihang Zhang, Liyu Fu, Jincheng Zhang, Yue Hao Xidian University	OD7(口头报告): 辉光放电光谱仪在镀层结构中的应用 武艳红, 许鹏 堀场(中国)贸易有限公司
17:45-18:00	OA8(口头报告): 高温热处理PVD AlN层中孔洞产生机理 贲建伟, 石芝铭, 臧行, 孙晓娟, 吕威, 黎大兵 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 中国科学院大学 长春工业大学	OB9(口头报告): 基于半极性GaN与量子点光刻胶的Micro-LED全彩显示器件 吴挺竹, 黄陈嵩文, 陈忠, 林岳, 郭浩中 厦门大学 台湾交通大学	OC9(口头报告): 基于氧氟复合等离子体处理工艺的增强型AlGaIn/GaN HEMT功率器件阈值电压稳定性研究 孙楠, 王荣华, 黄火林, 孙仲豪, 赵程, 宋书宽, 任永硕 大连理工大学 大连芯冠科技有限公司	OD8(口头报告): 基于新型增益机制的石墨烯异质结紫外光电探测器的研究 任显松, 郭霞 北京邮电大学

19:00-21:00

海报展示与交流(P-1~P-127)

8月6日（星期四）

分会报告	材料生长及物性表征 (三)	光电子材料与器件 (三)	功率电子与射频电子器件 (三)	新兴半导体材料及应用 (三)
主持人	唐宁	张源涛	冯志红	王科
8:30-8:50	IA6(邀请报告): Al(Ga)N材料的应变和缺陷调控 陈志涛, 何晨光, 赵维, 刘宁炆, 吴华龙, 张康, 贺龙飞 广东省科学院, 广东省半导体产业技术研究院	IB5(邀请报告): 深紫外发光器件外延生长的研究进展 戴江南, 张毅, 梁仁臻, 单茂诚, 郑志华, 陈长清 华中科技大学 鄂州工研院技术研究院 湖北深紫科技有限公司	IC5(邀请报告): GaN新器件技术及应用 孔月婵, 张凯, 吴立枢, 陈堂胜 南京电子器件研究所	ID6(邀请报告): 局域极化场调控的新型光电器件 王建禄 中科院上海技术物理研究所
8:50-9:10	IA7(邀请报告): AlGaIn基深紫外LED材料和器件研究 许福军, 沈波 北京大学	IB6(邀请报告): 应用于深紫外LED的MoOx/Al和Ni/Al高反射率p型电极 郭炜, 李亮, 叶继春 中国科学院宁波材料技术与工程研究所	IC6(邀请报告): 面向氮化镓电力电子器件产业化的可靠性评价 王荣华, 任永硕, 程万希, 黄火林, 梁辉南 大连芯冠科技有限公司 大连理工大学	ID7(邀请报告): 基于纳米图形模板的AlGaIn横向外延与紫外雪崩光电探测器 陈敦军, 蔡青, 游海帆, 汪金, 陆海, 张荣, 郑有焘 南京大学
9:10-9:30	IA8(邀请报告): AlN基材料制备、缺陷演变及紫外探测器研究 孙晓娟, 蒋科, 贲建伟, 张山丽, 开翠红, 吴忱, 臧行, 黎大兵 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 中国科学院大学	OB10(口头报告): 室温下半导体微腔激子polariton相干凝聚特性研究 朱海, 陈智阳, 郑湖颖, 汤梓荧 中山大学	OC10(口头报告): Direct Evidence of Hydrogen Interaction with Carbon: C-H complex in Semi-insulating GaN Shan Wu, Xuelin Yang, Weikun Ge, and Bo Shen School of Microelectronics, USTC	OD9(口头报告): 极宽禁带半导体AlN的紫外光学超表面微结构和器件研究进展 汪炼成, 胡泽林, 高祥, 李滔, 龙林云, 闫建昌 中南大学 中国科学院半导体研究所
9:30-9:45	OA9(口头报告): AlGaIn基深紫外LED的p型GaIn接触层选区生长研究 郭亚楠, 闫建昌, 张韵, 孙莉莉, 曾一平, 李晋闽, 王军喜 中国科学院半导体研究所 中国科学院大学 北京中科优唯科技有限公司	OB11(口头报告): 基于GaIn基WGM-FP混合腔体激光器的设计与研究 谢明远, 王永进, 施政 南京邮电大学	OC11(口头报告): 优化缓冲层的生长条件以提高硅基GaN功率器件的击穿电压 陈耀, 康双双, 胡建正, 闫龙, 周宁, 王文, 郭世平 中微半导体设备(上海)股份有限公司	OD10(口头报告): Metal-Semiconductor-Metal ϵ-Ga₂O₃ Solar-Blind Photodetectors with a Record-High Responsivity Rejection Ratio Yuan Qin, Liheng Li, Xiaolong Zhao, Haiding Sun, Kanhao Xue, Shibing Long, Ming Liu University of Science and Technology of China Huazhong University of Science and Technology
9:45-10:00	OA10(口头报告): Epitaxial Manufacturing Solutions for Compound Semiconductors Ziwen Fang, Jens Voigt, Thomas Korst, Martin Eickelkamp Assadullah Alam, Adam R. Boyd, Michael Heuken. AIXTRON SE	OB12(口头报告): MOCVD生长GaInP/GaInAsP 780-880nm高功率半导体激光器 朱振, 苏建, 孙素娟, 郑兆河, 王成新, 徐现刚 山东华光光电股份有限公司 山东大学	OC12(口头报告): GaN基p-i-n二极管雪崩击穿退化机制与新型终端结构研究 柏宇, 徐尉宗, 任芳芳, 周东, 陈敦军, 张荣, 郑有焘, 陆海 南京大学	OD11(口头报告): 基于SiC厚膜的p-i-n型X射线与α粒子探测器 刘清, 徐尉宗, 张衡, 张荣, 郑有焘, 陆海 南京大学
10:00-10:15	OA11(口头报告): 高Al组分硅基AlGaIn异质外延生长研究 黄应南, 刘建勋, 高宏伟, 孙秀建, 詹晓宁, 孙钱, 杨辉 中国科学技术大学纳米技术与纳米仿生学院 中科院苏州纳米技术与纳米仿生研究所	OB13(口头报告): 垂直外腔面发射激光器的材料生长及器件验证 李健, 汪超, 李川川, 韦欣 中国科学院半导体研究所	OC13(口头报告): 基于原位SiNx的薄势垒AlGaIn/GaN异质结电学特性研究 何佳琦, 蒋洋, 范梦雅, 汪青, 于洪宇 南方科技大学	OD12(口头报告): Enhance the stability of AlGaIn/GaN-HEMTs pH sensor by reference device Yan Dong, Beilei Ren, Zhijie Deng, Yanli Liu, Rui Wang, Jianming Lei, Quan Dai, Jeong-Gil Kim, Seung-Hyeon Kang, Chul-Ho Won, Dunjun Chen, Jung-Hee Lee, Hai Lu, Rong Zhang, Youdou Zheng Nanjing University Kyungpook National University Shandong Technology and Business University

分会邀请报告20分钟，口头报告15分钟(均含问答时间)

8月6日（星期四）

10:10-10:30 茶歇				
分会报告	材料生长及物性表征 (四)	光电子材料与器件 (四)	功率电子与射频电子器件 (四)	新兴半导体材料及应用 (四)
主持人	叶建东	陈鹏	王茂俊	陈敦军
10:30-10:50	IA9(邀请报告): InGaN/GaN量子点Micro-LED 汪莱, 王磊, 郝智彪, 罗毅 清华大学	IB7(邀请报告): 准范德华外延AlN及深紫外LED器件研究 魏同波, 常洪亮, 梁冬冬, 闫建昌, 王军喜, 刘忠范, 李晋闽 中国科学院半导体研究所 北京大学	IC7(邀请报告): 金刚石微波功率器件进展 冯志红, 蔚翠, 周闯杰, 郭建超, 何泽召, 宋旭波 中国电子科技集团公司第十三研究所	ID8(邀请报告): 高Al组分AlGaIn反常量子限域机制及其调控方法 陈荔, 郭炜, 林伟, 康俊勇, 叶继春 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 厦门大学
10:50-11:10	IA10(邀请报告): 纳米结构深紫外LED外延与新型器件 闫建昌, 张亮, 郭亚楠, 李晋闽, 王军喜 中国科学院半导体研究所	IB8(邀请报告): 利用衬底大斜切角和新型量子结构设计提高深紫外LED发光效率 孙海定 中国科学技术大学	IC8(邀请报告): 新型碳化硅电力电子器件探索研究 郭清 浙江大学	ID9(邀请报告): 石墨烯/氮化物界面诱导高灵敏光电探测器及其增益机制研究 胡安琪, 郭霞 北京邮电大学
11:10-11:30	IA11(邀请报告): 氮化镓中的碳杂质及相关点缺陷研究 杨学林, 张洁, 魏来, 冯玉霞, 沈波 北京大学	OB14(口头报告): 集成偏振的超像元结构InGaAs焦平面探测器研制 孙夺, 李雪, 杨波, 李淘, 杨力怡, 王世勇, 尹佳琪 中国科学院上海技术物理研究所	IC9(邀请报告): 微悬臂AlGaIn/GaN HEMT和仿神经网络控制系统 胡卫国 中国科学院北京纳米能源与系统研究所	ID10(邀请报告): MBE生长氮化物半导体材料及深紫外LED 王科, 李振华, 施根俊, 邵鹏飞, 吴耀政, 陶涛, 谢自力, 刘斌, 张荣, 郑有焘, N. Maeda, M. A. Khan, H. Hirayama 南京大学, 厦门大学, 日本国立理化学研究所 (RIKEN)
11:30-11:45	OA12(口头报告): 非极性AlGaIn基深紫外量子阱光学性质的研究 赵见国, 刘斌, 张雄, 常建华 南京大学 南京信息工程大学 东南大学	OB15(口头报告): 极化调制多量子垒EBL对AlGaIn基深紫外LED载流子输运性质的影响研究 郎婧, 许福军, 葛惟昆, 刘百银, 张娜, 孙元浩, 王嘉铭, 沈波 北京大学	OC14(口头报告): 铁电电荷存储栅叠层结构的增强型Ga₂O₃基MOSFET 蔡云匆, 封兆青, 冯倩, 张进成, 郝跃 西安电子科技大学	OD13(口头报告): 石墨烯上生长高质量GaIn厚膜及其自支撑衬底应用 徐俞, 曹冰, 郑树楠, 蔡德敏, 王明月, 张育民, 王建峰, 徐科 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 苏州纳维科技有限公司 苏州大学
11:45-12:00	OA13(口头报告): 柔性GaIn基HEMT的制备及性能调控研究 陈鑫, 董建奇, 王幸福 华南师范大学	OB16(口头报告): 基于全空间全向反射镜的深紫外发光二极管光学特性研究 张爽, 刘源, 张骏, 张毅, 许琳琳, 吴峰, 戴江南, 陈长清 华中科技大学	OC15(口头报告): 基于场板结构的β相氧化镓肖特基二极管 菅光忠, 何启鸣, 董航, 覃愿, 张颖, 徐光伟, 龙世兵, 刘明 中国科学院微电子研究所	OD14(邀请报告): 大尺寸MOCVD基座盘的制备与国产化 汪洋, 万强 湖南德智新材料有限公司 南京工业大学
12:00-12:15	OA14(口头报告): 高质量柔性氮化镓外延薄膜的生长 宁静, 闫朝超, 贾彦青, 王博宇, 王东, 张进成, 郝跃 西安电子科技大学	OB17(口头报告): 高性能斜台面AlGaIn紫外雪崩光电探测器 游海帆, 王海萍, 陈敦军, 张荣, 郑有焘 南京大学	OC16(口头报告): 氢终端金刚石MOSFET与AlGaIn/GaN HEMT直流特性与大信号特性对比 崔傲, 王东, 张金凤, 吴勇, 陈兴, 任泽阳, 陈军飞, 袁珂, 操焰 西安电子科技大学芜湖研究院 西安电子科技大学	OD15(口头报告): NiO/β-Ga₂O₃ II型异质结研究 巩贺贺, 徐阳, 陈选虎, 郝景刚, 叶建东, 顾书林, 张荣, 郑有焘 南京大学

分会邀请报告20分钟，口头报告15分钟(均含问答时间)